【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年7月23日(2009.7.23)

【公開番号】特開2006-344959(P2006-344959A)
【公開日】平成18年12月21日(2006.12.21)
【年通号数】公開・登録公報2006-050
【出願番号】特願2006-156335(P2006-156335)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　29/78　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/3205　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/52　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/8234　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/088　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　29/78　３０１Ｘ
Ｈ０１Ｌ　21/88　Ｓ
Ｈ０１Ｌ　27/08　１０２Ａ
Ｈ０１Ｌ　27/08　１０２Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月5日(2009.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板と、
前記半導体基板上に一方向に延びて形成されたゲート配線と前記ゲート配線に整列して前記半導体基板内に形成されたソース/ドレーン領域を含むトランジスタと、
前記ゲート配線上に前記ゲート配線と同一方向に延びて形成され、前記半導体基板に拡散されるイオンを遮断する拡散防止メタルパターンとを含む半導体集積回路素子。
【請求項２】
前記拡散防止メタルパターンは、第１配線と同一層に形成される請求項１に記載の半導体集積回路素子。
【請求項３】
前記拡散防止メタルパターンは、電気的にフローティング状態となる請求項２に記載の半導体集積回路素子。
【請求項４】
前記拡散防止メタルパターンには、所定電圧が印加される請求項２に記載の半導体集積回路素子。
【請求項５】
前記第１配線は前記トランジスタのソース領域にソース電圧を印加するソース電圧配線を含み、前記拡散防止メタルパターンは前記ソース電圧配線が延びて形成される請求項４に記載の半導体集積回路素子。
【請求項６】
前記第１配線は前記トランジスタのドレーン領域にドレーン電圧を印加するドレーン電圧配線を含み、前記拡散防止メタルパターンは前記ドレーン電圧配線が延びて形成される

請求項４に記載の半導体集積回路素子。
【請求項７】
前記第１配線は前記トランジスタのゲート配線にゲート電圧を印加するゲート電圧配線を含み、前記拡散防止メタルパターンは前記ゲート電圧配線が延びて形成される請求項４に記載の半導体集積回路素子。
【請求項８】
前記第１配線、拡散防止メタルパターンの全面上に前記半導体基板に拡散されるイオンを遮断する窒化膜をさらに含む請求項１に記載の半導体集積回路素子。
【請求項９】
前記第１配線、拡散防止メタルパターンの全面と前記窒化膜との間に酸化膜をさらに含む請求項８に記載の半導体集積回路素子。
【請求項１０】
前記トランジスタは、高電圧駆動トランジスタである請求項１に記載の半導体集積回路素子。
【請求項１１】
前記ソース/ドレーン領域は、前記ゲート配線に整列して形成され、前記半導体基板と異なる導電型の低濃度不純物領域と前記ゲート配線から所定距離離隔して前記低濃度不純物領域の深さより浅い深さで形成され、前記半導体基板と異なる導電型の高濃度不純物領域からなる請求項１０に記載の半導体集積回路素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体集積回路素子